|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号機PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル（AWJ装置）⑧　(1) | | | |
| c:\edax32\img\tempPath_01.bmp  SE | c:\edax32\img\tempPath_02.bmp  C | c:\edax32\img\tempPath_03.bmp  O (強いCrの信号に  影響される) | c:\edax32\img\tempPath_04.bmp  F (or Fe) |
| c:\edax32\img\tempPath_05.bmp  Na (or Zn) | c:\edax32\img\tempPath_06.bmp  Mg | c:\edax32\img\tempPath_07.bmp  Al | c:\edax32\img\tempPath_08.bmp  Si（Wの信号の影響  が含まれる） |
| c:\edax32\img\tempPath_10.bmp  S or Mo  （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_13.bmp  Cl(Ruの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_19.bmp  Ca（強いU,Teの信号に  影響される) | c:\edax32\img\tempPath_24.bmp  Ti or Ba |
| c:\edax32\img\tempPath_25.bmp  Cr | c:\edax32\img\tempPath_27.bmp  Mn(強いCrの信号に  影響される) | c:\edax32\img\tempPath_28.bmp  Fe | c:\edax32\img\tempPath_29.bmp  Co（Wの信号の影響  が含まれる） |
| c:\edax32\img\tempPath_30.bmp  Ni | c:\edax32\img\tempPath_02.bmp  Cu | c:\edax32\img\tempPath_33.bmp  Zn（強いWの信号に  影響される) | c:\edax32\img\tempPath_03.bmp  Zr |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-67 1uAWJ⑧のSEM-EDSマッピング (1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号機PCV内部調査アクセスルート構築関連サンプル（AWJ装置）⑧　(2) | | | |
| c:\edax32\img\tempPath_09.bmpMo or S  （強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_04.bmp  Mo(K線) | c:\edax32\img\tempPath_11.bmp  Tc  （強いMo,S,Ru, Pd,Ag ,Pbの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_12.bmp  Ru（強い Mo,S,Cl,Tc,  Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される） |
| c:\edax32\img\tempPath_14.bmp  Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_15.bmp  Pd（観察前蒸着分を含む  強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_16.bmp  Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される） | c:\edax32\img\tempPath_18.bmp  Sn（Uの信号の影響  が含まれる） |
| c:\edax32\img\tempPath_20.bmp  Te（Caの信号の影響  が含まれる） | c:\edax32\img\tempPath_21.bmp  I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの信号の影響が含まれる） | c:\edax32\img\tempPath_22.bmp  Cs（U及び強いTe,Ba,  Tiの信号の影響が含まれる） | c:\edax32\img\tempPath_23.bmp  Ba or Ti |
| c:\edax32\img\tempPath_26.bmp  Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる） | c:\edax32\img\tempPath_32.bmp  W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる） | c:\edax32\img\tempPath_34.bmp  Pb | c:\edax32\img\tempPath_17.bmp  U（Agの信号の影響が含まれる） |

注意事項：

(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。

(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。

(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。

(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

図4.1.1-68 1uAWJ⑧のSEM-EDSマッピング (2)